

关键指标

频率: 6~18GHz
功率增益: 23dB
1dB 压缩点输出功率: 31dBm
饱和输出功率: 32dBm
功率附加效率: 35%
电压/静态电流: +6V/480mA, Vg: -0.6V
芯片尺寸: 2.4mm×2.3mm

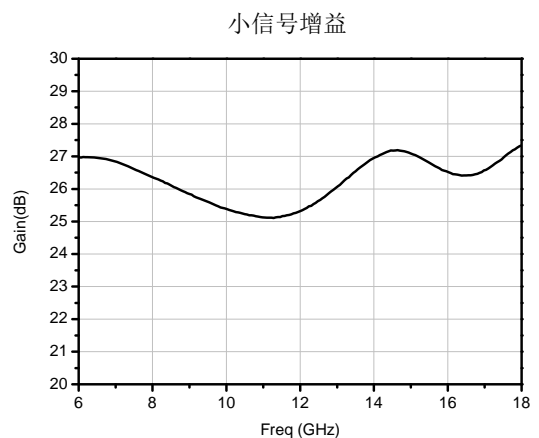
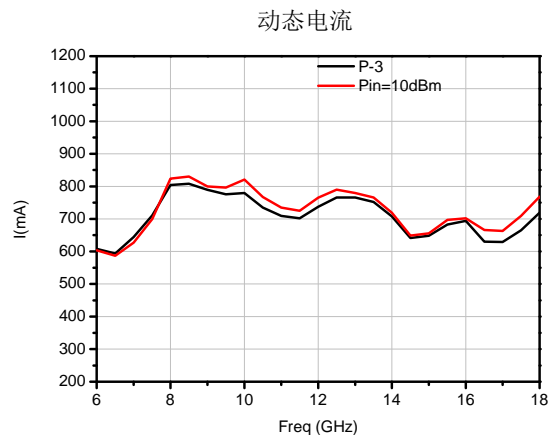
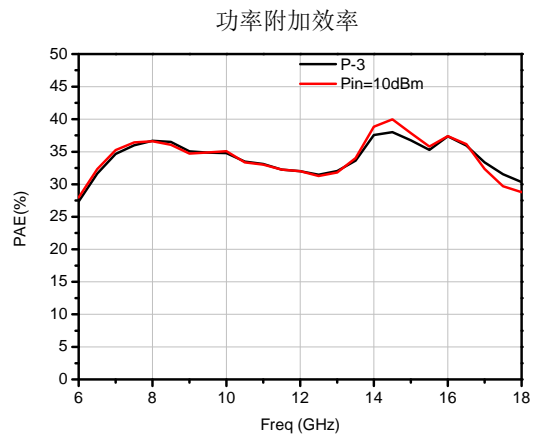
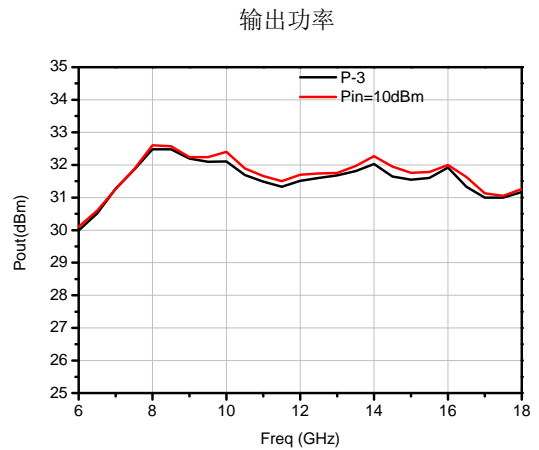
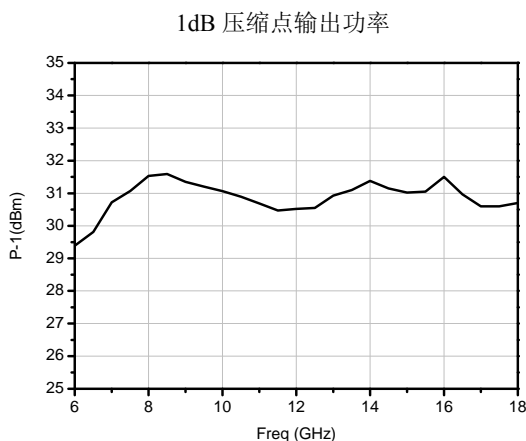
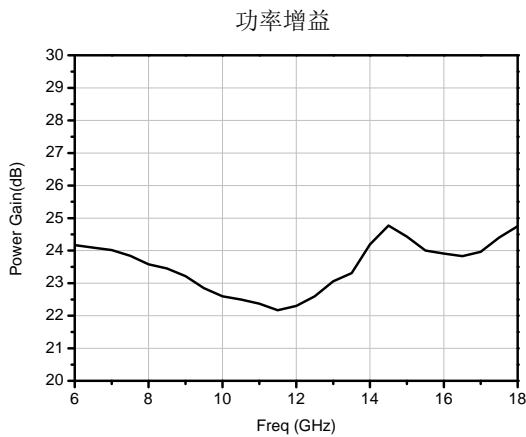
产品简介

HG136F12 功率放大器采用 GaAs pHEMT 工艺制作, 双电源供电, 静态电流为 480mA, 输入输出端均集成有隔直电容。

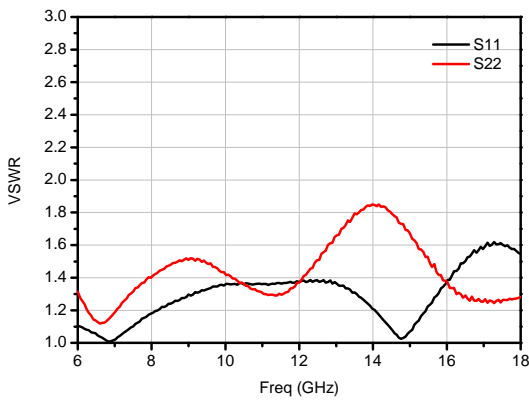
电性能 (T_A=25°C, V_{dd}=+6V, V_g=-0.6V)

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	6~18		
功率增益(dB)	-	23	-
输入/输出驻波	-	1.4/1.6	-
1dB 压缩点输出功率 (dBm)	-	31	-
饱和输出功率 (dBm)	-	32	-
功率附加效率 (%)	-	35	-
静态电流 (mA)	-	480	-

典型测试曲线

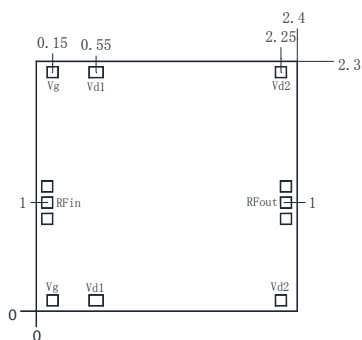


驻波

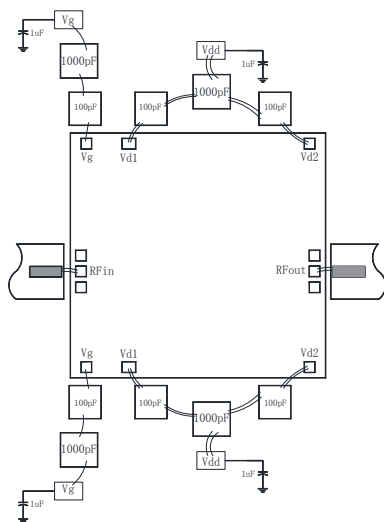


- 过 30 秒), 使之充分接地;
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm, 使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合, 建议金丝长度 250~400 μm ;
 5. 芯片微波端有隔直电容;
 6. 芯片对静电敏感, 在储存和使用过程中注意防静电。

外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



绝对额定最大值

工作电压	+8V
最大输入功率	+18dBm
工作温度	-55°C~125°C
存储温度	-65°C~150°C

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储, 在超净环境使用;
2. GaAs 材料较脆, 不能触碰芯片表面, 使用时必须小心;
3. 芯片用合金烧结 (合金温度不能超过 300°C, 时间不能超